1.68mm×1.68mm Silicon PD Chip datasheet

P/N: WS9M-01A

Application

Si PIN photodiode chips

Structure

Planar type：PIN diode

Electrodes ：

Top side（Cathode）: Al

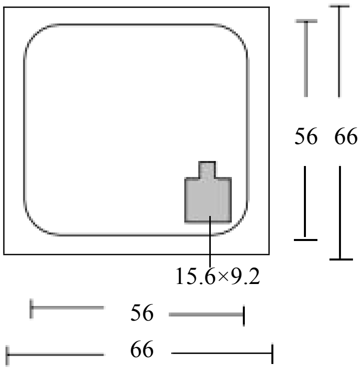
Backside（Anode） : Au Alloy

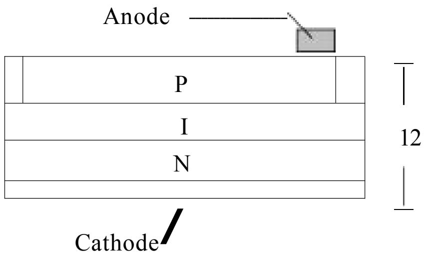
DIMENSIONS

Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Active	56 × 56			mil
Chip width	66 × 66 （± 1.0）			mil
Chip length	66 × 66 （± 1.0）			mil
Chip height	12（± 1.0）			mil
Pad N(Cathode)	15.6 × 9.2			mil
Pad P(Anode)	15.6 × 9.2			mil

Electro-Optical Characteristics（@ Ta＝25 ℃)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	VF	IF＝10mA, H＝0	0.5		1.3	V
Reverse Voltage	VBR	IR＝100μA, H＝0	35			V
Reverse Dark Current	ID	VR＝10V, H＝0			10	nA
Sensitive Wavelength Range	λp			940		nm
Capacitance	CJ	VR＝3V, F＝1 MHz		11		pF





Unit :mil